

Forward형 고주파 펄스 전원장치

(The Forward Type High Frequency Pulse Power Supply)

김 경식* · 원 재선** · 송 현직** · 김 동희** · 이 광식**

(Kyung-Sik Kim · Jae-Sun Won · Hyun-Jik Song · Dong-Hee Kim · Gwang-Sik Lee)

Abstract

The power semiconductor switching devices(PSSD) continuously developed, Power Electronic Technology using PSSD is gradually extended. The high frequency inverter to generate the large power high frequency subject to power electronic technology pursuit various applications. Also, in emboss with environmental destruction problem cause the atmosphere and the water pollution to growth of the commercial society, the research in favor of cleaning environmental a pollutant actively proceed. Therefore, This paper describe study on the high frequency pulse power supply. The theoretical results are in good agreement with the experimental ones. The proposed pulse power supply is considered to be useful for discharge lamp.

1. 서 론

전력용 반도체 스위칭 소자들이 속속 개발되어, 이를 사용한 전력 전자기술이 날로 발전하고 있다. 전력 전자기술은 대전력 고주파 등의 전력변환에 관한 다양한 응용분야를 구축하고 있다.[1][2]

산업사회의 발달로 대기 및 수질오염 등이 리우환경 회의 이후, 심각한 국제 환경파괴 문제로 부각되고 있으며, 국내에서도 화석연료 및 자동차 사용의 급증에 따라서 연소소에 발생되는 대기 오염물질로 인한 자연파괴, 농작물 피해, 스모그 현상 및 산성비 등으로 국민의 건강 및 보건에 심각한 위협이 초래되고 있다.

상술한 바와 같이 환경파괴 문제가 사회적인 문제로 부각됨에 따라 환경오염물질을 정화하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.[3][4][5]

펄스 파워기술의 그 응용분야가 환경정화 뿐만 아니라 반도체 장치의 고집적화에 따른 미세가공과 어류 양식 분야에 이르기까지 다양하게 응용되고 있다.

펄스 파워기술은 종래의 고전압·대전류 공학을 기초로 하여 콘덴서 및 인덕터 등에 저장된 초기 전자에너지를 시간적으로 성형·증첩·압축하여 수ns~수ms의 짧은 시간안에 고출력(10TW이상도 가능)을 발생시켜 좁은 공간에 에너지를 집중 공급하는 기술이다.[6]

지금까지의 Pulse 발생용 전원장치는 상용주파수 전원을 입력으로 하여 콘덴서의 충·방전 전압에 의한 고전압 발생기(Pulse Generator)가 일반적으로 사용되어 왔고, 이러한 장치의 외형이 대형화되어서 취급이 불편할 뿐만 아니라 가격면에서도 고가로 되는 단점이 있다. 따라서, 본 연구에서는 상기와 같은 기술적 배경을

기초로 하여 상용화의 관점에서 회로구성이 간단하고 취급이 용이한 Forward형 펄스 전원장치의 회로동작과 전원장치의 특성 및 전원장치의 방전특성을 검토하였다.

더욱이, 펄스 전원장치를 제작하여 O₃발생기를 부하로 하였을 때 이론해석과 특성해석의 정당성을 입증하였다.

2. Forward형 고주파 펄스 전원장치

2.1. 주회로 및 회로해석

그림 1은 본 연구를 통해 고주파 고전압 출력전압을 발생시키기 위한 Forward형 고주파 펄스전원장치의 주회로 구성을 나타내고 있다. 펄스 전원장치에 인가하는 펄스전압의 최대값은 브리지 정류회로의 위상각 제어에 의해 이루어지고 있으며, 펄스 전압은 Power-MOSFET(S)의 온·오프에 의해 펄스 주기가 정해진다.

일반적으로 고주파 펄스전압의 경우 펄스 발생에는 7[kV]의 Pulse전압이 요구된다.

본 회로의 특징은

- i) 회로구성이 간단하다.
- ii) 장치의 소형·경량화가 용이하다.
- iii) Pulse 주파수 가변 및 Pulse의 상승시간 단축이 용이하다.
- iv) 상용화 시킬 경우 가격면에서 유리하다는 등을 들 수 있다.

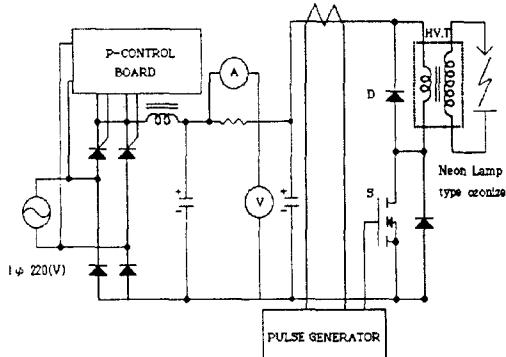


그림 1. Forward형 고주파 펄스 전원장치
Fig. 1. Forward Type Pulse Power Supply

본 회로의 사양은 입력 전압 : 220(V), 1φ이며, 용량은 1(kVA), 사용 주파수는 0.4~3(kHz)으로 하였으며, 이러한 조건 하에서 출력 펄스 전압은 무부하시 최대전압은 15(kV)이며, 부하시 최대전압은 10(kV)이다.

그림 1의 회로의 동작모드는 스위치(S)와 다이오드(D)의 온·오프 동작에 따라서 두 개의 동작모드로 분류할 수 있다.

각 모드에 따른 회로 상태방정식을 회로해석을 행하기 위하여 백터-행렬 형태로 표현하면 다음과 같다.

$$\frac{dX}{dz} = A \cdot X + B \cdot U$$

$$Y = C \cdot X$$

여기서, $X = [i_1(t) \ i_2(t) \ v_R(t)]^T$

$$U = [1 \ 0 \ 0]^T, \ A = \frac{M}{(M^2 - L_1 L_2)} \text{ 이고}$$

각 모드별 A, B, C는 다음과 같다.

Mode 1

$$A = \begin{bmatrix} \frac{AL_2R_1}{M} & -AR_2 & -A \\ -AR_1 & \frac{AL_1R_2}{M} & \frac{AL_1}{M} \\ 0 & \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$$

$$B = [-\frac{AL_2E_d}{M} \ AE_d \ 0]^T$$

$$C = [0 \ 1 \ 0]$$

Mode 2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -AR_2 & -A \\ 0 & \frac{AL_1R_2}{M} & \frac{AL_1}{M} \\ 0 & \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}$$

$$B = [0 \ 0 \ 0]^T$$

$$C = [0 \ 1 \ 0]$$

2.2. 고압 Pulse 변압기

고압 펄스전압을 발생하기 위해 고주파에 동작하는 승압용 변압기가 필요하다. 고압 펄스 변압기를 제작함에 있어 우선적으로 고려하여야 할 사항은 권선간의 절연과 펄스 전압을 전송시 발생하는 권선간의 분포 정전용량이다.

따라서, 그림 2에서 보는 바와 같이 2차 권선을 분할 설치하였으며, 분포 정전 용량을 최소화시켜 고속 스위칭시 펄스의 링깅 현상을 억제시켰다. 그림 1 및 2의 고압 Pulse 변압기에 사용한 소자 및 정격은 표 1과 같다.

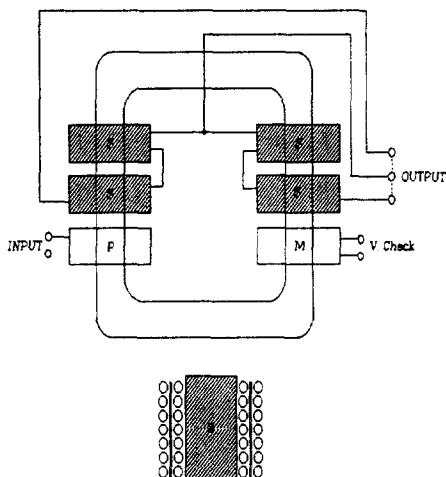


그림 2. 고압 Pulse 변압기

Fig. 2. High Voltage Pulse Transformer

표 1. 사용한 소자와 정격
Table 1. Using Devices and Rating

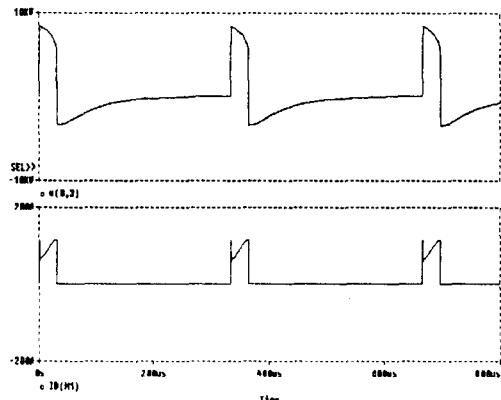
Using Devices	Rating
1 MOSFET	400(V), 120(A)
2 DEEI	600(V), 20(A) (High speed)
3 Primary side	4T(3.5mm ²)
3 Secondary side	200T(0.25mm ²)
4 CORE	U Type ferrite (High frequency)

3. 고주파 펄스 전원장치의 특성

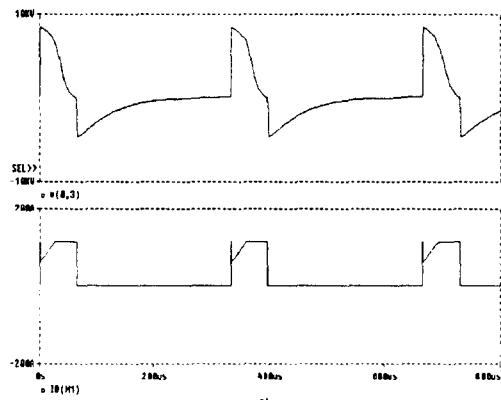
그림 3(a)(b)는 시뮬레이션 툴인 PSpice를 사용하여 스위칭 주파수 3(kHz)인 경우, 출력주파수와 드티비에 따른 출력 전압(kV)과 스위치에 흐르는

전류(A)의 변화를 보여주고 있다.

그림에서 알 수 있듯이, 뉴티비가 적을수록 출력 전압파형 및 스위치에 흐르는 전류가 이상적인 펄스파에 근접하고 있으며, 뉴티비가 증가함에 따라 고압변압기에 포화 현상이 나타나 실제 출력 전압이 감소함을 알 수 있다.



(a) 3kHz, Duty Ratio 10%



(b) 3kHz, Duty Ratio 20%

그림 3. 출력전압(kV)과 스위치 전류(A)

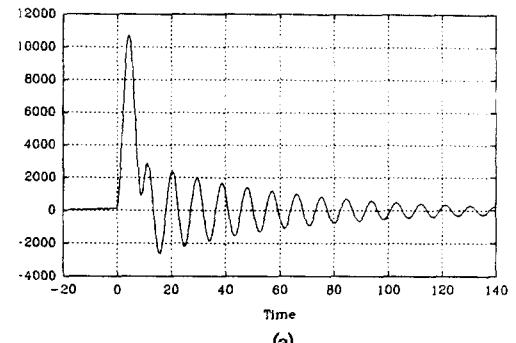
Fig. 3. Output voltage and Switch current

그림 4(a)는 3(kHz), 출력전압 13(kV)의 경우, 이론해석을 통해서 얻은 무부하시 출력 Pulse전압을 나타내고, 그림 4(b)는 Pspice를 이용한 시뮬레이션을 통해서 얻은 무부하시 출력펄스 전압, 그림 4(c)는 실험을 통하여 얻은 무부하시 출력 Pulse전압을 나타내고 있다.

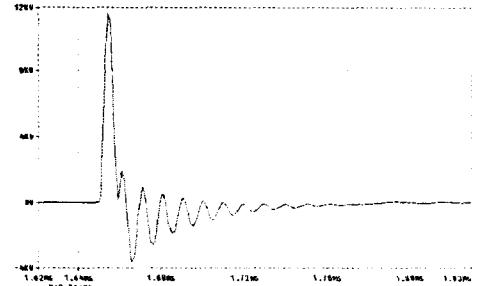
실측 과정에서부터 알 수 있듯이, Peak값까지 도달하는 상승시간은 1.4~1.8(μ s)이고, Peak전압 상승률은 2~2.1(kV)/200(ns)이어서 효과적인 Pulse 출력 전압임을 확인하였다.

수치해석한 이론파형과 Pspice파형 및 실험파형의 경향이 거의 일치하고 있어 이론해석의 정당성

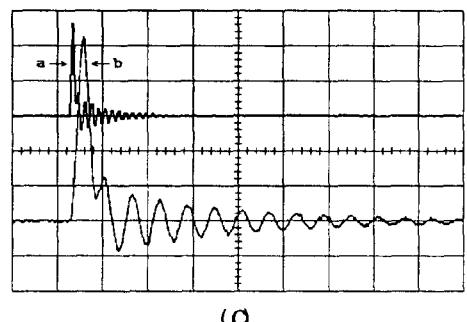
을 뒷받침하고 있다.



(a)



(b)



(c)

a : (Voltage : 500/div, Time : 20 μ s/div)

b : (Voltage : 250/div, Time : 5 μ s/div)

그림 4. 무부하시 출력 펄스 전압

Fig. 4. Output Pulse voltage for no load
(Frequency : 3 [kHz], Output Voltage : 13 [kV])

그림 5는 그림 1의 스위치(S)에 인가되는 펄스 신호를 발생하는 신호 발생회로 및 스위치의 드라이브 회로를 보여주고 있다. 신호 발생은 VCO기능을 가진 MCI4046을 사용하여 출력주파수를 제어하고 있으며, MCI4528에 의해 뉴티비를 변화시키고 있다.

그림 6은 출력주파수 3(kHz), 뉴티비 10(%)인 경우의 출력전압의 실측파형을 보여주고 있다. 실측파형으로부터 본 개발한 장치가 Pulse 발생용 전원장치로서 유효함을 확인할 수 있다.

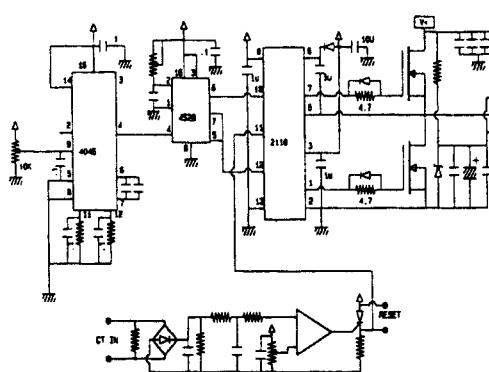


그림 5. 신호 발생 회로
Fig. 5. Signal Generation Circuit

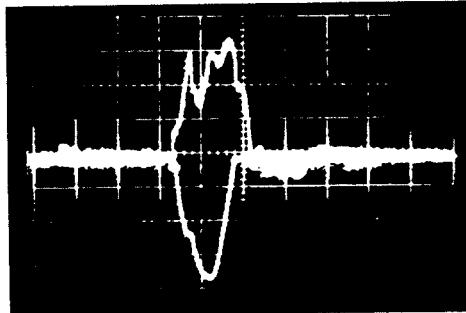


그림 6. 출력전압의 실측파형
Fig. 6. Experimental waveforms of output volta
(3kV/div, 25A/div)

4. 펄스 전원장치의 방전특성

그림 7은 고주파 펄스 전원장치를 부하인 램프형 오존발생기에 적용하여 방전특성 및 오존생성 능도 특성을 연구하기 위하여 사용된 실험장치의 배치도를 나타낸 것이다.

이 오존생성능도는 램프형 오존발생기의 무성방전에 의하여 생성된 오존화 가스를 자외선 흡수방식의 기상용 오존 monitor(0~100,000[ppm], Okitronics社, 일본)를 사용하여 매실험마다 0.3[l/min]로 표본추출하여 측정하였다. 여기서 원료가스의 온습도는 특별히 조정하지 않았으며, 램프형 오존발생기로부터 오존 monitor까지의 거리는 최단거리 300[mm]로 구성하였다.

그리고 램프형 오존발생기의 방전특성을 조사하기 위하여 오존발생기로부터 출력되는 방전전압 및 그때의 파형을 측정하였다. 이때 전압파형은 고전압 probe(주파수 대역 ; DC ~ 50[MHz], 내압 ; 50[kV], 분압비 ; 2000 : 1)에 의하여 감쇄된 전압을 digital storage oscilloscope (LeCroy 9350AL, 500[MHz], 1[Gs/s]), 퍼스널 컴퓨터 및 프린터를 사용하여 측정 및 출력하였다.

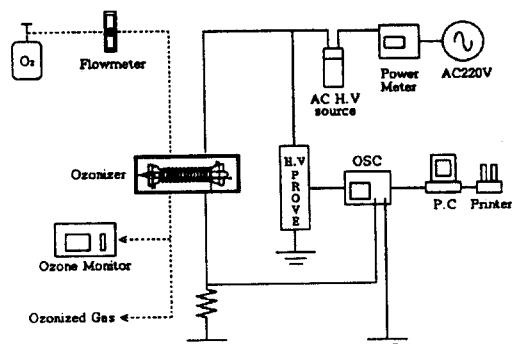


그림 7. 램프형 오존발생장치의 배치도
Fig. 7. Arrangment diagram of lamp type ozonizer

그림 8은 펄스 전원장치 출력전압의 최대치까지 도달하는 시간폭(width)이 1.8[μ s]이고 원료가스의 유량이 각각 2[l/min]일 때, 방전전압 및 주파수 변화에 따른 오존생성능도 특성을 나타낸 것이다.

그럼에서와 같이 각 주파수에서 방전전압이 증가됨에 따라서 오존생성능도가 상승하였고, 방전전압이 일정한 경우, 주파수가 증가할수록 오존생성능도가 상승하였다.

즉, 주파수가 증가할수록 램프형 오존발생기의 gap에서 무성방전에 의하여 발생된 전자수는 무성방전의 발생빈도에 비례하게 되어 산소분자를 해리하여 오존을 생성하는 반응이 활성화되어, 오존생성능도가 상승하는 것으로 사료된다.

그 결과 방전전압이 10.7[kV]이고 주파수가 3.0[khz]인 경우 그림 8에서 최대 8600[ppm]의 오존생성능도를 얻을 수 있었다.

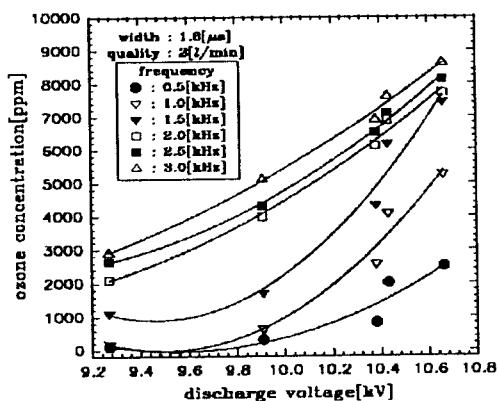
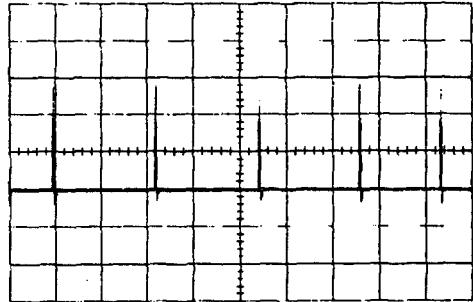
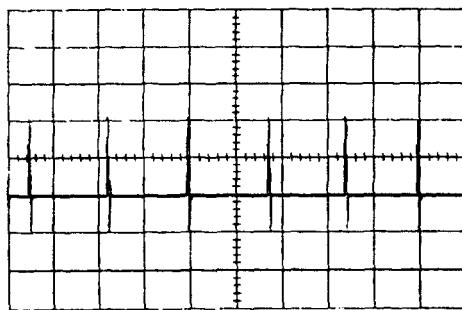
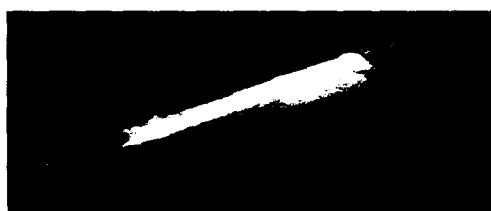


그림 8. 방전전압과 오존생성능도의 특징
Fig. 8. Characteristics of discharge voltage vs.
ozone concentration

그림 9의 (a), (b)는 width가 1.8[μ s]이고 방전전압이 2.8[kV]이며, 주파수의 변화에 따른 램프형 오존발생기의 외관 및 방전전압 파형을 측정한 것이다.



(a) 주파수: 1 [kHz], 1 [kV/div], 0.5 [ms/div]



(b) 주파수: 3 [kHz], 1 [kV/div], 0.2 [ms/div]

그림 9. 램프형 오존발생기의 외관과 방전 전압파형

Fig. 9. Photograph of ozonizer and waveforms of discharge voltage

5. 결론

본 연구는 최근의 반도체 스위칭 소자(Power-MOSFET)를 이용하여 상용화의 관점에서 회로구성이 간단하고 취급이 용이한 Forward형 펄스 전원장치를 연구 대상회로로 하여 회로동작과 전원장치의 특성 및 전원장치의 방전특성을 검토하였다.

Pulse 전원장치는 출력전압의 주파수 및 펄스폭을 가변할 수 있도록 하여 방전량을 용이하게 조정하도록 하였다.

본 장치의 특성을 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

1. Power-MOSFET를 적용한 Pulse 전원장치가 출력전압 10(kV)에서도 안정된 운전이 가능함을 확인하였다.
2. 본 장치의 전기적인 특성은 출력 Peak 전압 까지 도달하는 상승시간이 1.4~1.8(μ s), Pulse 전압상승률은 2~2.1(kV)/200(ns)로 효과적인 Pulse 전압을 얻을 수 있었다.
3. 본 전원장치에서 출력되는 Pulse전압으로 부하인 램프형 오존발생기에 적용하여 특성실험을 행한 결과 만족할 만한 결과를 얻을 수 있었다.

이상의 결과로부터 고주파·고전압 Pulse 전원장치의 소형 경량화가 가능하여졌고, 상용화시킬 경우 저 가격으로 경쟁력이 있으리라 사료된다.

또, 본 장치는 대장균 살균, 탈취, 멸균, 표면살균, 탈색 및 NOx 가스제거 등과 같이 오존을 이용하는 다양한 분야로의 활용이 가능할 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] K. Kit Sum and Bruce W. Carsten: "Trends in High Frequency Power Conversion", HPPC, pp. 198~204, May, 1988
- [2] A. Tsui: "Commutating SOA Capability of Power-MOSFET S", IEEE APEC, pp. 481~485, 1990.
- [3] C. Blanco: "An Improved Electronic Transformer for Low Power Halogen Cycle Lamps", IEEE IAS, vol. 3, pp. 1979~1983, 1994
- [4] H. J. Song, K. S. Lee, "A study on the high voltage nozzle type ozonizer", 11th International Conference on Gaseous Discharge and Their Applications, vol. 2, pp. 320~323, 1995.
- [5] 김종해, 배상준, 이영식, 조기연, 정성균, 이봉설, "오존 발생 기용 전원장치 개발 및 특성에 관한 연구", 전기학회 하계 학술대회, PEP 2, pp. 2069 ~2071, 1997
- [6] 이형호, 김영배, "고전압·대전류 pulsed power의 이용기술", 전기학회 하계 학술대회, DHO 14, pp.1678~1680, 1997